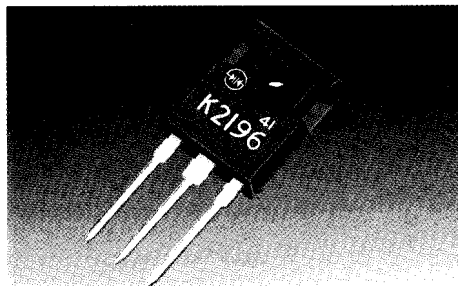
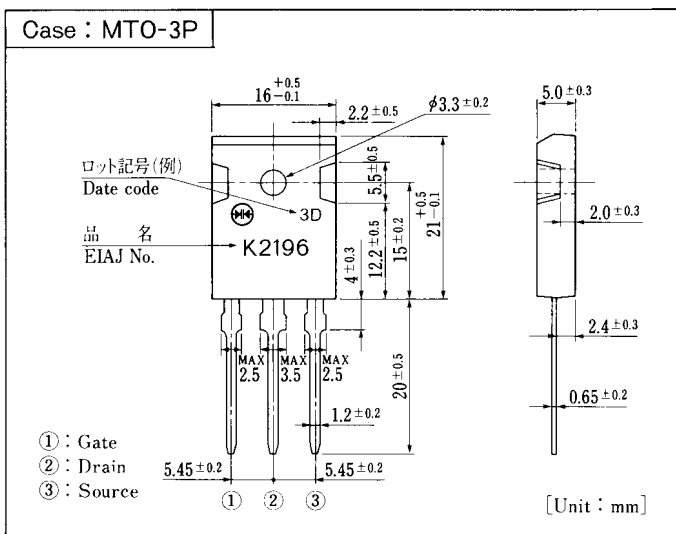


2SK2196
(F20W50VX2)

500V 20A



■ 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		500	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V _{GSS}		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	20	A
	Peak	I _{DP}	60	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		20	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T		125	W
単発アバランシェ電流 Single pulse Avalanche Current	I _{AS}		20	A
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5N・m) (Recommended torque: 0.5N・m)	0.8	N・m

■ 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (Tc=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	500			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =500V, V _{GS} =0V			250	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V			±100	nA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =10A, V _{DS} =10V	6	15		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(on)}	I _D =10A, V _{GS} =10V		0.27	0.35	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =1mA, V _{DS} =10V	2.5	3.0	3.5	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =10A, V _{GS} =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case			1.0	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =10V, I _D =20A, V _{DD} =400V		85		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		2400		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			170		
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			500		
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =10A, V _{GS} =10V, R _L =15Ω		135	225	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			340	565	